

SJT1837PF PNP型硅三极管

描述

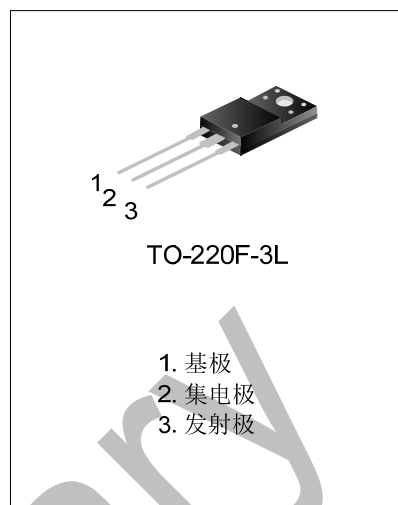
SJT1837PF PNP 型硅三极管采用士兰微电子平面三极管工艺技术制造。

该产品主要应用在 20W 高保真音频放大输出。

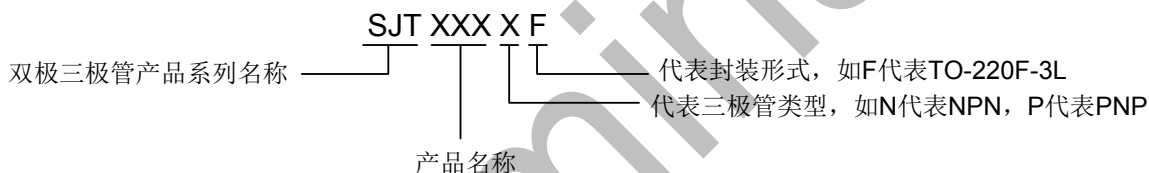
SJT1837PF 三极管目前可提供 TO-220F-3L 封装外形。

特点

- * 较高的击穿电压。
- * 很小的漏电电流。



产品命名规则



产品规格分类

产 品 名 称	封装形式	打印名称	材料	包装
SJT1837PF	TO-220F-3L	SJT1837PF	无铅	料管

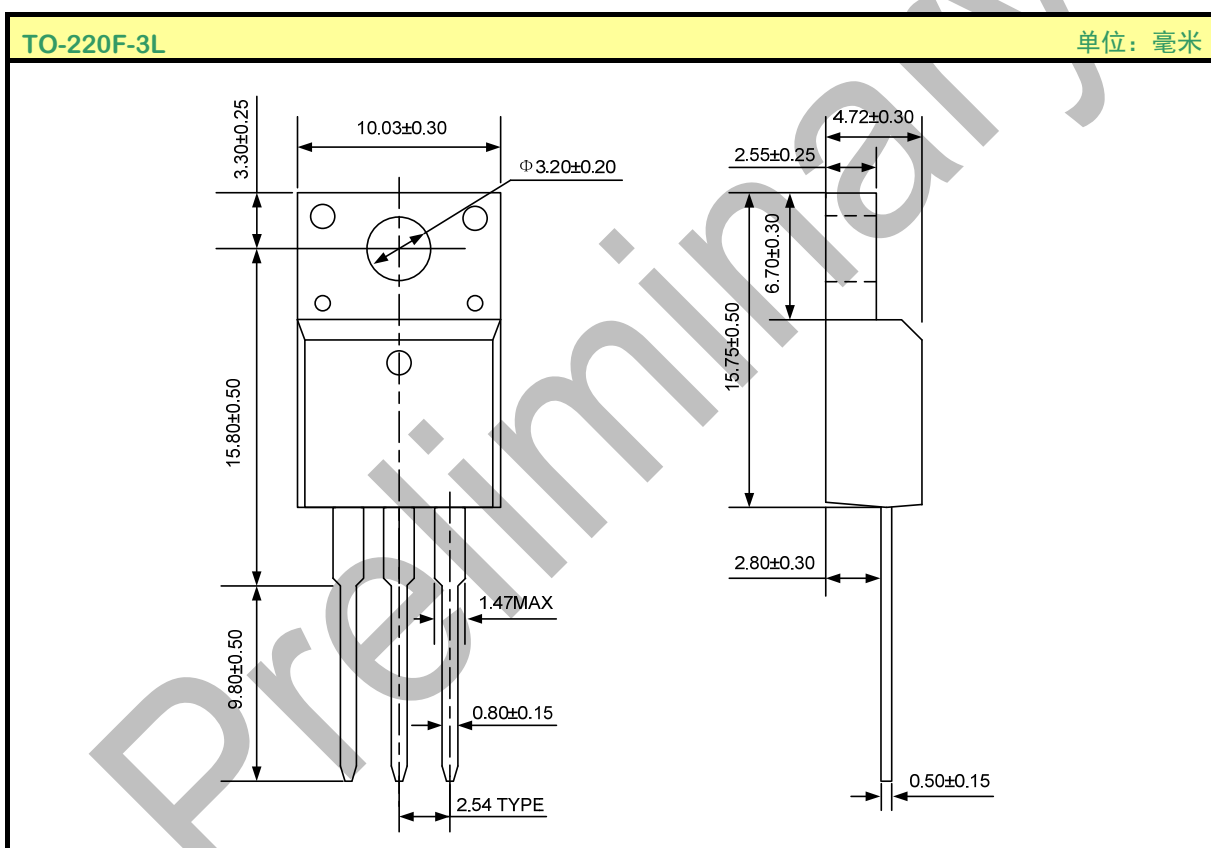
极限参数(除非特殊说明, $T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参 数	符 号	参 数 范 围		单 位
集电极、发射极击穿电压	BV_{CEO}	-250	$I_C=1\text{mA}, I_B=0$	V
发射极、基极击穿电压	BV_{EBO}	-5	$I_E=1\text{mA}, I_C=0$	V
集电极、基极击穿电压	BV_{CBO}	-250	$I_C=100\mu\text{A}, I_E=0$	V
集电极电流	I_C	-1		A
基极电流	I_B	-0.1		A
工作结温	T_J	150		$^{\circ}\text{C}$
存储温度范围	T_{stg}	-55~+150		$^{\circ}\text{C}$
集电极耗散功率 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	P_C	20		W

电参数(除非特殊说明, $T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参 数	符 号	测 试 条 件	最小值	典型	最大值	单位
直流电流增益	HFE	$V_{CE}=-5\text{V}$, $I_C=-100\text{mA}$	100	-	320	-
集电极、发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-500\text{mA}$, $I_B=-50\text{mA}$	-		-1	V
基极、发射极电压	V_{BE}	$V_{CE}=-5\text{V}$, $I_C=-500\text{mA}$	-	-	-1	V
集电极、基极漏电电流	I_{CBO}	$V_{CB}=-250\text{V}$, $I_E=0$	-	-	-1	μA
发射极、基极漏电电流	I_{EBO}	$V_{EB}=-5\text{V}$, $I_C=0$	-	-	-1	μA
集电极输出电容	C_{OB}	$V_{CB}=-10\text{V}$, $I_C=0$, $f=1\text{MHz}$	-	30	-	pF

封装外形图



声明:

- 士兰保留说明书的更改权, 恕不另行通知! 客户在下单前应获取最新版本资料, 并验证相关信息是否完整和最新。
- 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能, 买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!
- 产品提升永无止境, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!